نشريه مهندسي عمران اميركبير

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره ۵۰، شماره ۶۰ سال ۱۳۹۷، صفحات ۱۱۴۵ تا ۱۱۵۴ DOI: 10.22060/ceej.2018.11202.4987

بررسی مکانیزم تاثیر غلظت کلکتور در جدایش انتخابی گالیم از روی به روش فلوتاسیون یونی

زهرا بهری'، بهرام رضایی'*، الهه کوثری'

۱ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران ۲ گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده: عنصر روی از جمله ناخالصی موجود در محلولهای اسیدی در منابع گالیم است که در این تحقیق جدایش انتخابی گالیم از روی به روش فلوتاسیون یونی مطالعه شد. با توجه به اینکه غلظت کلکتور از جمله پارامترهای عملیاتی تاثیرگذار بر فرایند فلوتاسیون یونی است، مکانیزم تاثیر غلظت کلکتور سدیم دو دسیل سولفات در جدایش انتخابی یون گالیم از یون روی در ۲=PH بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کلکتور، تعاملات الکترواستاتیکی بین گالیم و سر آنیونی از سدیم دو دسیل سولفات افزایش می یابد و منجر به تشکیل کمپلکسهای نامحلول (سابلت) می شود. مکانیزم رفتار و مشخصات کمپلکسهای نامحلول با استفاده از آنالیزهای اسپکتروفتومتری، هدایت الکتریکی، پراکندگی نور دینامیکی و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. نتایج آنالیزها نشان داد که متوسط اندازه کمپلکسهای نامحلول ناشی از افزایش غلظت کلکتور بر ضریب مینجابی گالیم نسبت به آلومینیم تاثیر دارد. با افزایش غلظت کلکتور، متوسط اندازه کمپلکسهای نامحلول کاهش می یابد و منجر به حمل یونهای روی بیشتر به فاز کف و کاهش ضریب انتخابی گالیم می شود. جدایش انتخابی به گالیم از یون روی در غلظت هم مولار از دو یون (M ⁺ ۱۰۰×۲۵۰) در غلظت M⁺ ۲۰۰×۲۵۰) از سدیم دو دسیل سولفات بدست آمد.

تاریخچه داوری: دریافت: ۱۵ آذر ۱۳۹۵ بازنگری: ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ پذیرش: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ارائه آنلاین: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

> **کلمات کلیدی:** فلوتاسیون یونی یون گالیم جدایش انتخابی روش هدایت سنجی

۱– مقدمه

گالیم یک عنصر فلزی در گروه ۱۳ از جدول مندلیف است. این عنصر در سال ۱۸۷۵ توسط یک شیمی دان فرانسوی به نام پائول–ایمیل لکو^۲ کشف شد [۱]. این عنصر کاربرد وسیعی در صنعت الکترونیک دارد. گالیم همراه با آرسنیک (گالیم آرسنید) به عنوان نیمه هادی در سلولهای فتوولتائیک^۲، سوپر کامپیوتر، دیویدهای لیزری^۲، دستگاههای مایکروویو، دیوی–دیها، سلولهای خورشیدی و دستگاههای الکترونیک دیگر استفاده شده است [۲]. ایزوتوپ (Ga⁶⁷) از گالیم در پزشکی هسته ای برای اسکن بیماران استفاده شده است. اهمیتی از اسکن گالیم به علت توانایی آن در تشخیص تومور است. همچنین ایزوتوپی از گالیم برای تسکین درد استخوان آسیب دیده استفاده شده است [۳]. معمولا گالیم به عنوان محصول ثانویه از بوکسیت (جهت شده است [۳]. معمولا گالیم به عنوان محصول ثانویه از بوکسیت (جهت منابع دیگر گالیم خاکستر زغال (که شامل ۱۰۰ از یون گالیم است) و منابع دیگر گالیم خاکستر زغال (که شامل ۱۰۰ از یون گالیم است) و قراضههای صنعت الکترونیک است [۸–۴]. در این تحقیق استخراج انتخابی یون گالیم از یون روی به روش فلوتاسیون یونی بررسی شد. فلوتاسیون

*نویسنده عهدهدار مکاتبات: rezai@aut.ac.ir

یونی از سال ۱۹۶۰ توسط سبا^۴ به عنوان یک فرایند جداسازی شناخته شده است. فلوتاسیون یونی به علت مزایایی مانند، سادگی، نیاز به انرژی کم، اقتصادی، عملکرد جداسازی خوب (R>۹۵٪) برای غلظت های کم (mol/l ۲۰-۱۰- ۲۰- ۱۰۰)، انعطاف پذیری تجهیزات، یک روش موثر و منحصر بفرد برای بازیابی عناصر با ارزش از محلول های رقیق است [۹]. با توجه به اینکه روش فلوتاسیون یونی⁶ برای محلول های خیلی رقیق از یون ها (غلظت های کم) قابل اجرا است و با توجه به اینکه غلظت گالیم در محلول منابع خیلی کم است، بنابراین احتمالا روش فلوتاسیون یونی نسبت به روش-های دیگر مقدمتر است. در این مطالعه به دلیل اینکه عنصر روی از جمله ناخالصی موجود در محلول های اسیدی در منابع گالیم است، استخراج انتخابی گالیم از روی با استفاده از سدیم دو دسیل سولفات (کلکتور) به روش فلوتاسیون یونی بررسی شد. در فرایند فلوتاسیون یونی، ابتدا محلول هموژن (همگن) است و بعد از اضافه کردن یک ماده سطحفعال با بار مخالف یون، هتروژن (ناهمگن) می شود. بنابراین به علت واکنش بین ماده سطحفعال و یون، کمپلکس های نامحلول (سابلت³) تشکیل می شود که این کمپلکس های نامحلول با اتصال به سطح حباب هوا به فاز كف انتقال يبدأ مي كنند [١٠].

4 Seba

¹ Paul – Emile Lecoq de Boisbaudran

² Photovoltaic Cells

³ Laser Diode

⁵ Ion Foltation

⁶ Sublate

با توجه به انحلال پذیری محصول یون – کلکتور، یک یا بیش از چندین مکانیزم در طول عملیات فلوتاسیون یونی رخ می دهد. برای مثال اگر واکنش بین گونههای کاتیون یا آنیون (کالیجند') با ماده سطحفعال یک جفت یون یا کمپلکس محلول تشکیل شود، فرایند جزءبه جزء کف^۲ (فلوتاسیون یونی همگن) نامیده می شود [۱۰ و ۱۱]. اگر کالیجند ابتدا توسط یک یون غیر فعال سطح (عامل رسوب) یا با تغییر PH رسوب کند و سپس ذرات رسوب نامیده می شود [۲۰–۱۰]. بطور کلی نوع فرایندها توسط سینتیک حذف و انحلال پذیری از محصول کلکتور –کالیجند شناسایی می شود.مطالعه محققان نشان داده است که تعدادی پارامتر های عملیاتی و هیدرودینامیکی مانند، نیزوی یونی، غلظت یون، PH محلول، غلظت کلکتور، نرخ هوادهی و غیره نیزوی یونی، غلظت یون، Pt محلول، غلظت کلکتور، نرخ هوادهی و غیره

مطالعات قبلی ما نشان داد که ضریب انتخابی یون گالیم نسبت به یون روی به روش فلوتاسیون یونی در غلظت ثابت سدیم دو دسیل سولفات در pH=۲ بیشترین مقدار است [۱۹]. در این مطالعه با توجه به اینکه غلظت کلکتور از جمله پارامترهای عملیاتی تاثیرگذار بر فرایند فلوتاسیون یونی است، مکانیزم تاثیر افزایش غلظت کلکتور سدیم دو دسیل سولفات در جدایش انتخابی گالیم از یون روی در ۲=pH بررسی شد. مکانیزم و رفتار تاثیر افزایش غلظت کلکتور در جدایش انتخابی گالیم از یون روی با استفاده از آنالیزهای اسپکتروفتومتری، هدایت الکتریکی، پراکندگی نور دینامیکی و میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد.

۲- مواد و روشها

۲- ۱- آمادهسازی نمونه و معرفها

نیترات گالیم⁷ و نیترات روی^{*} از مرک خریده شد. سدیم دو دسیل سولفات (مرک ۹۸٪) به عنوان کلکتور و کفساز خریده شد. از هیدروکسید سدیم و اسید هیدروکلریک تهیه شده از مرک برای تنظیم pH محلول استفاده شد. این معرفها با استفاده از آب دو بار تقطیر آمادهسازی شد و بعد از ۱۲ ساعت استفاده شدند. آزمایشهای فلوتاسیون یونی در ماشین فلوتاسیون آزمایشگاهی نوع دنور اجرا شد. در این مطالعه، همه پارامترهای هیدرودینامیکی و عملیاتی به جز مقدار کلکتور در طول همه آزمایشها ثابت نگه داشته شد. نمودار توزیع گونهها و دادههای آزمایشگاهی نشان داد که در HP بیشتر از ۲، گالیم به صورت Ga(OH) رسوب خواهد کرد [۹۹]. بنابراین جهت جلو گیری از رسوب گالیم و بررسی فلوتاسیون یونی در جدایش انتخابی یون گالیم از روی کلیه آزمایش ها در ۲= HP انجام شد شکل ۲. یک لیتر از محلول هم مولار گالیم و روی آماده شد و مقدار مشخص از سدیم دو دسیل سولفات به محلول اضافه شد. سپس فلوتاسیون توسط ورود

1 Colligend 2 Foam Fractionation 3 Ga(NO₃)₃*xH₂O 4 Zn(NO₃)₂*4H₂O

هوا آغاز شد و کف به مدت ۱۰ دقیقه جمع آوری شد. بعد از فلوتاسیون، برای جلوگیری از رسوب یون، محلول باقیمانده در سلول توسط محلول ۱ تا ۳ مولار^۵ HCl اسیدی شد و سپس غلظت یونهای باقیمانده در سلول توسط آنالیز ICP-OES^۶ اندازه گیری شد. رسوبات جدا شده دو بار توسط آب مقطر شسته و در دمای اتاق خشک شد و سپس آنالیز میکروسکوپ الکترونی^۷ (SEM) بر روی نمونهها انجام شد. درصد حذف یونها بر طبق رابطه زیر محاسبه شد [۲۰]:

$$R(\%) = [1 - (C / C_0)] \times 100 \tag{1}$$

 C_0 که C غلظت یون باقی مانده در محلول در طول آزمایش است و C_0 غلظت ابتدایی از یون در محلول خوراک است. در تست ها غلظت یون های (روی و گالیم) یکسان و ثابت (M) در نظر گرفته شد.

ضریب انتخابی مربوط به تبادل یونی از رابطه زیر محاسبه شد [۲۱]:

$$K_X^{\text{Ycharge}} = \frac{R_1}{R_2} \tag{(7)}$$

که $R_2 = \frac{R_1}{X}$ ضریب انتخابی بار ظاهری، $R_1 = \frac{R_2}{X}$ درصد حذف یونهای گالیم و روی به ترتیب است.

۲-۲- اندازه گیری اسپکتروفتومتری

تعامل بین یون گالیم و سدیم دو دسیل سولفات توسط روش اسپکتروفتومتری در غلظت $M^{*-1} \times 10^{-1}$ از سدیم دو دسیل سولفات مطالعه شد. محلولی با M $^{*-1} \times 10^{-1}$ از گالیم آماده و بعد از اضافه کردن سدیم دو دسیل سولفات به محلول، طیف جذب الکترونی از محلول توسط روش اسپکتروفتومتری لامبدا[^] ۴۵ ثبت شد.

۲ –۳ – اندازه گیری هدایت الکتریکی

تکنیک اندازه گیری هدایت الکتریکی با هدایت سنج مدل جن وی^۴ ۴۵۱۰ مطالعه شد. یک محلول ۲۰/۰۱ نرمال از کلرید پتاسیم^{۱۰} با رسانایی ۱۴۱۳ میکروموس برای کالیبره کردن واحد و سلول هدایت سنج آماده شد و سپس هدایت الکتریکی نمونه ها اندازه گیری شد. ۲۲ نمونه T۰ ml حاوی ۱ mM گالیم در محدوده غلظت mM ۱–۱۰ از سدیم دو دسیل سولفات در TH= آماده سازی شد و سپس ده دقیقه بعد از اضافه کردن سدیم دو دسیل سولفات به هر محلول، هدایت الکتریکی همه نمونه ها اندازه گیری شد.

5 Molar

- 7 Scanning Electron Microscopy
- 8 Lambda 9 Jenway
- 10 Potassium chloride

⁶ Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy

T- ۴- اندازه گیری پراکندگی نور دینامیکی^۱ (DLS)

اندازه گیری DLS برای تعیین اندازه کمپلکسهای تشکیل شده در محلول و تاثیر آن بر ضریب انتخابی گالیم نسبت به روی با استفاده از زتا سایزر^۲ مطالعه شد. اندازه گیریها در دمای ۲۵ درجه سیلسیوس انجام شد. چهار نمونه ۲۰ mN حاوی ۱ mM گالیم با غلظت ۸ mM ۰/۰، ۱/۸ و ۲/۴ از سدیم دو دسیل سولفات در ۲=pH آماده شد. ده دقیقه پس از اضافه کردن سدیم دو دسیل سولفات به هر محلول، اندزه کمپلکسهای تشکیل شده با استفاده از سلولهای کوارتز ۱ cm ۱ ثبت شد.

۳- نتایج و بحث

۳- ۱- تاثیر غلظت سدیم دو دسیل سولفات بر جدایش انتخابی

همه تستها در pH=۲ پیش از رسوبات هیدروکسید از یون ها اجرا شد. گونههای اصلی در محلول در این مقدار +BH، Ga³⁺ و Zn²⁺ است. برای بررسی تاثیر انحلال پذیری ناشی از تعامل بین کلکتور و یون ها در جدایش انتخابی یون گالیم از یون روی، تاثیر غلظت سدیم دو دسیل سولفات بر درصد حذف گالیم و روی توسط روش فلوتاسیون یونی مطالعه شد. شکل ۳ نتایج حاصل از آزمایشها در سیستم گالیم-روی آب را نشان میدهد. همانطور كه ملاحظه مى شود با افزايش غلظت كلكتور، سطح حذف گاليم افزایش می یابد، اما ضریب انتخابی یون گالیم نسبت به یون روی ابتدا افزایش و سپس به سرعت به مقدار ۲۰ درصد کاهش می یابد. بر طبق مطالعه محققان قبلي، مرتبه انتخابي جذب و تعامل كاتيون ها با مواد سطح فعال آنیونی در فلوتاسیون یونی مربوط به بار یونی و پتانسیل یونی (نسبت بین بار یون و شعاع یونی) از کاتیون ها است [۲۴-۲۲]. یک کاتیون فلزی با ظرفیت بالاتر (بار یونی بالاتر) و پتانسیل یونی بالاتر در جدایش انتخابی از محلول توسط مواد سطحفعال آنيوني مقدمتر است [۲۴-۲۲]. نتايج نشان داد كه درصد حذف گالیم بیشتر از یون روی است. با توجه به اینکه بار و شعاع یونی گالیم بالاتر از یون روی است، بنابراین جدایش انتخابی یون گالیم از محلول توسط مواد سطحفعال أنيوني مقدم تر است. نتايج بدست أمده در اين مطالعه مشابه نتایج و مطالعه محققان قبلی از لحاظ بار یونی و پتانسیل یونی است.

سه محدوده مختلف با توجه به تغییر شیب نمودار در شکل ۳ شناسایی شد. درصد حذف گالیم با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات تا غلظت شد. درصد حذف گالیم با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات به یون گالیم ۲/۱) به سرعت افزایش یافت. در این مرحله هیچ سابلتی (کمپلکس نامحلول) در محلول مشاهده نشد. افزایش درصد حذف گالیم با افزایش غلظت کلکتور منبوب به افزایش تعاملات الکترواستاتیکی بین گالیم و سر آنیونی از سدیم دو دسیل سولفات بین ^{*}-۱۰×۸/۱ تا مدیم دو دسیل محلول مشاهد کلکتور مدیم محلول مشاهده نشد. در غلظت سدیم دو دسیل سولفات به یون گالیم ۲/۱) منسوب به افزایش تعاملات الکترواستاتیکی بین گالیم و سر آنیونی از سدیم دو دسیل سولفات بین ^{*}-۱۰×۸/۱ تا کلکتور به غلظت کالکتور به غلظت کار تا ۳)، درصد حذف گالیم با شیب کمتر و همراه با تشکیل رسوبات سفید (کمپلکس نامحلول)

رخ داد. اگر چه با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات، درصد حذف گالیم افزایش می یابد اما نمودار ضریب انتخابی نشان داد که ضریب انتخابی یون گالیم نسبت به یون روی تا غلظت سدیم دو دسیل سولفات ۲۰۰۴×۱/۵ مولار (نسبت غلظت کلکتور به غلظت یون ۱) افزایش می یابد و سپس کاهش می یابد.



شکل ۱: پارامترهای تاثیر گذار در فرایند فلوتاسیون یونی

Fig. 1. Affected parameters on the ion-flotation performance



شکل ۲: دیاگرام گونه هایی از یون های گالیم ((Ga(III)) و روی (ZN(II))

Fig. 2. The speciation diagram of Ga(III) and Zn(II) species as a function of pH

¹ Dynamic light scattering (DLS)

² Zeta Sizer



شکل ۳: (الف) تاثیر غلظت سدیم دو دسیل سولفات بر درصد حذف گالیم و روی (M ^۲۰۰×۱/۵) در pH=۲ ب) ضریب انتخابی گالیم نسبت به روی برای مقدار غلظتهای مختلف از سدیم دو دسیل سولفات

Fig. 3. Fig. 3. Effect of SDS concentration on the percentage removal of Ga(III) and Zn(II) (1.5×10⁻⁴ M) at pH=2 (b) Selectivity coefficients of Ga(III) over Zn(II) for the different SDS concentration value



شکل ۴: طیف اسپکتروفتومتری از الف) محلول M ^۱-۱۰×۱/۵ از گالیم ب) سیستم گالیم– سدیم دو دسیل سولفات در غلظت هم مولار (۱/۵×۱۰^{-۲} M)

Fig. 4. Spectrophotometric spectra of a) Gallium solution (1.5×10⁻⁴ M) b) system gallium- SDS at co-molar concentration (1.5×10⁻⁴ M)

۳- ۲- مطالعه مکانیزم جدایش

جهت بررسی تاثیر غلظت سدیم دو دسیل سولفات در جدایش گالیم، تعامل بین گالیم با سدیم دو دسیل سولفات با استفاده از تکنیکهای اسپکتروفتومتری، هدایت الکتریکی، پراکندگی نور دینامیکی و آنالیز میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد.

۳- ۲- ۱- مطالعه اسپکتروفتومتری

M برای بررسی تاثیر کلکتور سدیم دو دسیل سولفات (غلظت M برای بررسی تاثیر کلکتور سدیم دو دسیل سولفات (غلظت M ⁻⁻⁻۱۰/۰×۱۰) در جدایش یون گالیم، تعامل بین سدیم دو دسیل سولفات و یون گالیم به روش اسپکتروفتومتری در T=H مطالعه شد. تغییر حداکثر طیف جذب گالیم (در غلظت گالیم M ⁻⁻ ۱۰×۱۰/۱) در غیاب و حضور سدیم دو دسیل سولفات (۱/۵۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱) در شکل ۴ ارائه شده است. محلول M ⁻⁻ ۱۰۰۰×۱/۵) گالیم ماکزیمم جذب در m ۲۸۰ نشان داد. نتایج دو طیف نشان داد که در حضور سدیم داد که در حضور سدیم دو دسیل سولفات پیکهای جذب جدید ایجاد شد اما تغییری در حداکثر جذب رخ نداد. بنابراین تعامل بین گالیم و سدیم دو دسیل

سولفات ایجاد شده است اما با توجه به اینکه حداکثر جذب تغییری نکرده است کمپلکس نامحلول تشکیل نشده است. بنابراین همانطور که در مقدمه بحث شد و نتایج آنالیز ICP نشان داد تا غلظت M^{*-۱}۸×۱/۵ از کلکتور مکانیزم جزءبه جزء کف (فلوتاسیون یونی همگن) در عملیات فلوتاسیون یونی رخ داده است.

۳- ۲- ۲- تکنیک هدایت الکتریکی

آنالیز هدایت الکتریکی، تکنیک قابل اعتماد برای شناسایی تغییرات رفتار یونی از محلول است؛ بنابراین تغییرات خواص محلول توسط تغییرات هدایت الکتریکی مطالعه شد [۲۵]. نتایج آزمایشها بر اساس پارامترهای میسلی بحث شد. شکل ۵ تاثیر حضور نیترات گالیم بر هدایت الکتریکی از محلولهای سدیم دو دسیل سولفات را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در حضور نیترات گالیم (غلظت ۱ mM ا) تغییرات معنیداری در روند هدایت الکتریکی رخ میدهد. اگرچه تفسیر هدایت الکتریکی محلول



شکل ۵: تاثیر یون گالیم (۱ mM) بر هدایت الکتریکی محلول آبی سدیم دو دسیل سولفات

Fig. 5. Effect of the collector concentration on the conductimetric of 1mM Ga3+ solution



شکل ۶: هدایت الکتریکی (K) در مقابل نسبت (Ga(III) ا غلظت سدیم دو دسیل سولفات] (دادههای نشان دار) در دمای K ۱۵/۲۹۸ و مشتق دوم متناظر (خط ممتد) برای محاسبه mic و cmc

Fig. 6. Electrical conductivity (K) versus [SDS]/ Ga(III) at temperature of 298.15 and second derivative (continuous line) for calculating mic and cmc

همانطور که در مقدمه بحث شد، به علت انحلال پذیری محصول تعامل یون کلکتور، مکانیزمهای مختلفی ممکن است در طول فرایند فلوتاسیون یونی رخ دهد. با توجه به تحلیلها، فرایند جزءبهجزء کف (فلوتاسیون یونی همگن) و فلوتاسیون یونی، و تشکیل همی میسل در شکل ۲ ارائه شده است. به علت ماهیت غلظت و گونه ها نسبتا پیچیده است، شکل ۶ سه انتقال فاز بین چهار رژیم مختلف از سیستم را نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که در نسبت مولار بزرگتر از ۱ کاهش واضحی در شیب مشاهده می شود و در محدوده وسيعي از غلظت كلكتور (تا نسبت مولار ۲/۸) این كاهش شیب ادامه مى يابد. محققان نقطه شروع كاهش شيب هدايت الكتريكي را غلظت توده بحرانی یا cac' نامیدند [۲۷– ۲۵]. بنابراین مقدار cac برای مطالعه محلول mM اگالیم برابر با نسبت مولار ۱ (غلظت کلکتور ۱ mM) است. کاهش هدایت الکتریکی نشان میدهد که افزایش غلظت کلکتور سدیم دو دسیل سولفات به محلول گالیم هیچ افزایش ظاهری از گونههای یونی در کل محلول ایجاد نمی شود بنابراین تغییر در خواص ساختاری از گونه های یونی در محلول وجود دارد. با اضافه کردن کلکتور به محلول، تودههای دو دسیل سولفات گالیم تشکیل شده است و در نتیجه تحرک یونی و همچنین هدایت یونی افزایش نخواهد یافت. مطالعات نشان داده است که تعامل بین یونهای سه ظرفیتی با میسلهای سدیم دو دسیل سولفات عمدتاً الكترواستاتيكي و ضعيف است [٢٩-٢٧]. بعد از اينكه تمام يون هاي گاليم موجود در محلول با کل غلظت سدیم دو دسیل سولفات تشکیل کمیلکس نامحلول دهند، افزایش بیشتر سدیم دو دسیل سولفات، منجر به افزایش هدایت الکتریکی خواهد شد. مطالعات نشان داده است که این غلظت از كلكتور، حداكثر غلظت تعامل يا mic نام دارد [۳۴-۲۹]. بنابراين مقدار mic برای مطالعه محلول ۱ mM گالیم توسط فیت دادههای خام از هدایت الکتریکی با یک تابع غیر خطی ساده محاسبه شد و برابر با مقدار ۲/۸ مولار از كلكتور بدست آمد. نسبت اتصال (β) (تعرف شده به عنوان =//mic) β[(Ga(III)]) که اطلاعاتی درباره نسبت استوکیومتری مورد نیاز بین یون گالیم و یون های سولفات دو دسیل در تشکیل توده را نشان میدهد نیز محاسبه و برابر ۲/۸ بدست آمد. بنابراین فرایند تشکیل کمپلکس بین گالیم و سديم دو دسيل سولفات بدين صورت ارائه شد:

$$Ga^{3+}(aq) + 3DS^{-} \Leftrightarrow Ga(DS)_{3}(aq) \tag{(7)}$$

¹ Critical aggregation concentration



pH=۲ شکل ۷: مکانیزمهای مختلف عملیات فلوتاسیون یونی با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات در Fig. 7. Different ion- flotation operation mechanisms with increasing SDS concentration at pH=2.1

۳- ۲- ۳- مطالعه پراکندگی نور دینامیکی (DLS)

برای مطالعه بیشتر کمپلکسهای تشکیل شده توسط سدیم دو دسیل سولفات، اندازه گیری پراکندگی نور دینامیکی برای تعیین اندازه کمپلکسهای تشکیل شده در محلول آبی اجرا شد. شکل ۸ نتایج DLS در غلظتهای مختلف از سدیم دو دسیل سولفات را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود، پیک پراکندگی خیلی تیز است، این پیک شامل تشکیل کمپلکس و شعاعهای غیر یکنواخت از کمپلکسهای تشکیل شده است. متوسط اندازه کمپلکس برای غلظتهای سدیم دو دسیل سولفات M ۸/۰، ۸/۸ و ۳/۵ به ترتیب ۳۳۲ شاطت سدیم دو دسیل سولفات تا ۳۵۸ متوسط اندازه می شود با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات تا ۲/۴ mM مراد مادازه کمپلکس ها کاهش می یابد.

اضافه کردن کلکتور سدیم دو دسیل سولفات به محلول گالیم منجر به تشکیل کمپلکسهایی با ابعاد کوچکتر می شود که این کاهش ابعاد کمپلکسها با افزایش غلظت کلکتور تا T/۴ mM ادامه دارد. با توجه به اینکه نسبت استوکیومتری مورد نیاز بین گالیم و کلکتور سدیم دو دسیل سولفات در تشکیل کمپلکس برابر با ۲/۴ است، بنابراین کاهش متوسط اندازه کمپلکس تا غلظت کلکتور T/۴ mM به علت افزایش تشکیل کمپلکس بین سدیم دو دسیل سولفات و گالیم است. بعد از اینکه تمام یونهای گالیم موجود در محلول با سدیم دو دسیل سولفات تشکیل کمپلکس دهد، توده رسوبی در محلول با سدیم دو دسیل سولفات تشکیل کمپلکس دهد، میلکس می شود. همانطور که ملاحظه می شود متوسط اندازه کمپلکس در حضور Mm ۱ گالیم و MM ۵۳ از سدیم دو دسیل سولفات افزایش یافته

است. بنابراین یکی از دلایل کاهش ضریب انتخابی گالیم ممکن است به علت جذب یونهای روی در سطح کمپلکسهای نامحلول است. با توجه به اینکه با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات متوسط اندازه کمپلکس کاهش مییابد کمپلکسهای تشکیل شده منجر به حمل یونهای روی بیشتری به فاز کف می شود، بنابراین منجر به کاهش ضریب انتخابی گالیم خواهد شد.

٣- ٢- ۴- مطالعات ميكروسكوپ الكتروني

برای بررسی تاثیر غلظت سدیم دو دسیل سولفات بر خصوصیات رسوبات، مورفولوژی رسوبات در طول دو آزمایش با غلظت سدیم دو دسیل سولفات mM⁻¹۰۲×۱۲ و ^۲-۱۰×۲/۷ توسط میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. شکل ۹ تصاویر میکروسکوپ الکترونی از رسوبات را نشان می دهد. مطالعههای محققان قبلی نشان داده است که ریختشناسی از رسوبات در طول فرایند فلوتاسیون یونی بستگی به شرایط فیزیکی و شیمیایی از آزمایشها دارد [۳۵]، بطور مشابه این مطالعه نتایج یکسانی را نشان داد.

همانطور که مشاهده می شود، رسوبات در مقدار غلظت سدیم دو دسیل سولفات ۳M^{-۴} ۲/۷×۱۰^{-۴} ابعاد کوچکتری دارند و این نتایج مشابه نتایج مطالعه پراکندگی نور دینامیکی است. این ابعاد کوچکتر منجر به حمل یون های روی بیشتر به فاز کف می شود و منجر به کاهش ضریب انتخابی یون گالیم نسبت به یون روی می شود.



شکل ۸: توزیع اندازه از کمپلکسهای تشکیل شده در محلول ۱ mM گالیم در حضور الف) ۸ mM ۸/۰ ب) ۱۸ mM ۲/۴ ج) ۲/۴ د) ۳/۵ سدیم دو دسیل سولفات

Fig. 8. Distribution of the complexes size formed in gallium solution of 1mM in the presence of a) 0.8 mM b) 1.8 mM c) 2.4 mM d) 3.5 mM of SDS



شکل ۹: تصاویر میکروسکوپ الکترونی از رسوبات جدا شده در مقدار غلظت سدیم دو دسیل سولفات (الف) ۳/۱×۱۰^{-۴} M(ب) ۲/۱×۱۰^{-۴}

Fig. 9. Images of electron microscopy from isolated sediments at SDS concentration of a) 2.1×10^{-4} mM b) 2.7×10^{-4} mM

۳- ۳- ارتباط بین بازیابی آب و حذف یون روی

انتخابی فرایند فلوتاسیون یونی تحت تاثیر بازیابی یون ها و آب در کف است. بنابراین تاثیر غلظت سدیم دو دسیل سولفات بر بازیابی گالیم و روی به عنوان تابعی از بازیابی آب مطالعه و نتایج در شکل ۱۰ ارائه شد. همانطور که مشاهده می شود، با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات در ۲=pH نه تنها بازیابی آب افزایش یافته است بلکه درصد حذف یون روی نیز افزایش

یافته است. مطالعههای محققان پیشین نشان داده است که سدیم دو دسیل سولفات خاصیت کفسازی دارد بنابراین با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات کف بیشتری تولید می شود در نتیجه بازیابی آب افزایش می یابد. بنابراین یکی از دلایل افزایش حذف یون روی و کاهش ضریب انتخابی گالیم با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات منسوب به افزایش بازیابی

آب و بنابراین افزایش دنباله روی یون های روی به دنبال یا روی حباب هوا است. همانطور که در شکل ۱۰ مشاهده می شود تا غلظت M^{*+}۰۰×۲/۴ از سدیم دو دسیل سولفات یون روی با شیب کمتری نسبت به بازیابی آب حذف می شود اما افزیش بیشتری از غلظت سدیم دو دسیل سولفات منجر به حذف یون روی با شیب بیشتری نسبت به بازیابی آب می شود. همانطور که در قسمت هدایت الکتریکی مطالعه شد نسبت استوکیومتری مورد نیاز بین گالیم و یون های سدیم دو دسیل سولفات در تشکیل کمپلکس برابر با ۲ است. بنابراین مقدار بازیابی آب کمتر در غلظت سدیم دو دسیل سولفات کمتر از M^{*+}۰۱×۲/۴ منسوب به تشکیل کمپلکس گالیم با تمامی سدیم دو ۲۰۰×۲/۴ مید از تشکیل کمپلکس گالیم با تمامی سدیم دو مقدار سدیم دو دسیل سولفات اضافی منجر به تولید کف بیشتر، افزایش مقدار سدیم دو دنبال روی بیشتر یون های روی به دنبال یا روی حباب می شود. بنابراین حذف یون روی نسبت به بازیابی آب با شیب بیشتری رخ می دهد.



شکل ۱۰: درصد حذف یون (گالیم و روی) در مقابل بازیابی آب به عنوان تابعی از غلظت سدیم دو دسیل سولفات

Fig. 10. Percentage removal of ion (gallium and zinc) versus water recovery as a function of SDS concentration

۴- نتیجهگیری

- نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سدیم دو دسیل سولفات، درصد حذف گالیم افزایش مییابد اما ضریب انتخابی گالیم نسبت به یون روی تا غلظت کلکتور M^{-*} ۱۰×۱/۵ مولار (نسبت غلظت کلکتور به غلظت گالیم ۱) افزایش و سپس کاهش مییابد.
- ۲. مطالعه پراکندگی نور دینامیکی و میکروسکوپ الکترونی نشان
 داد که با افزایش غلظت کلکتور تا نسبت غلظت کلکتور به غلظت
 گالیم ۲/۸، متوسط اندازه کمپلکس های نامحلول کاهش می یابد.

بنابراین یکی از دلایل کاهش ضریب انتخابی گالیم از ۱ تا ۲/۸ به علت جذب یون های روی در سطح کمپلکس های نامحلول است.

- ۳. مطالعه اسپکتروفتومتری و هدایت الکتریکی نشان داد که با توجه به انحلال پذیری کمپلکس بین گالیم و سدیم دو دسیل سولفات در غلظتهای کلکتور پایین تر از M^{*-۱۰×۸۸} (نسبت غلظت کلکتور به غلظت گالیم ۱) فرایند جزءبه جزءکف و در غلظتهای کلکتور بالاتر از M^{*-۱۰×۸۱} فرایند فلوتاسیون یونی رخ می دهد.
- ۲. نتایج آنالیزها نشان داد که در نسبت غلظتهای کلکتور به گالیم کمتر از ۱ ضریب انتخابی گالیم نسبت به روی وابسته به بار یونی و پتانسیل یونی از یونها است و در نسبت غلظت های کلکتور به گالیم بیشتر از ۱ ضریب انتخابی علاوه بر اینکه تحت تاثیر بار یونی و پتانسیل یونی است بلکه تحت تاثیر ابعاد کمپلکسهای تشکیل شده در محلول و بازیابی آب است.
- ۵. مطالعات هدایت الکتریکی نشان داد که برای محلول mM ا از گالیم در pH=۲ و در حضور سدیم دو دسیل سولفات، مقدار غلظت توده بحرانی (cac)، ماکزیمم غلظت تعامل (mic) و غلظت میسیلی بحرانی (cmc) برابر با mM ۱، ۲/۸ و ۴ است
- ۶ مطالعه هدایت الکتریکی نشان داد که نسبت استوکیومتری بین گالیم و کلکتور سدیم دو دسیل سولفات برابر با ۲/۸ است. بنابراین فرایند تشکیل کمپلکس بین گالیم و سدیم دو دسیل سولفات توسط رابطه زیر ارئه شد.

 $Ga^{3+}(aq) + 3DS^{-} \Leftrightarrow Ga(DS)_{3}(aq)$

۵- تشکر و قدردانی

نویسندگان از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کل کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و بنیاد ملی نخبگان بخاطر تامین هزینه مالی این مقاله تشکر و قدردانی می کنند.

مراجع

- [1] R.R. Moskalyk, Gallium: the backbone of the electronics industry, Minerals Engineering, 16 (2003) 921-929.
- [2] O. Font, X. Querol, R. Juan, R. Casado, Recovery of gallium and vanadium from gasification fly ash, Journal of hazardous materials, 139 (2007) 413-423.
- [3] I.M. Ahmed, Y.A El-Nadi, N.E. El-hefny, Extraction of gallium from hydrochloric acid by cyanex 923 and cyanex 925, Hydrometallurgy, 131 (2013) 24-28.
- [4] D.O. Flamini, S.B. Saidman, J.B. Bessone, Electrodeposition of gallium onto vitreous carbon, Journal of Applied Electrochemistry, 37 (2007) 467-471.

- [19] Z. Bahri, B. Rezai, and E. Kowsari, Selective separation of gallium from zinc using flotation: effect of solution pH value and the separation mechanism, Minerals Engineering, 86 (2016) 104-113.
- [20] M.H Ehrampoush, M.H. Salmani, M.T. Ghaneian, M. Davoudi, M.H. Fallahzadeh, Selectivity in removal of cadmium(II) from mixed metal effluents using ion flotation, World Applied Science Journal, 13(1) (2011) 52-59.
- [21] C. Micheau, A. Schneider, L. Girard, P. Bauduin, Evaluation of ion separation coefficients by foam flotation using a carboxylate surfactant, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 470 (2015) 52–59.
- [22] Z. Bahri, B. Rezai, E. Kowsari, Evaluation of cupferron on the selective separation of gallium from aluminum by flotation: The separation mechanism, Minerals Engineering, 98 (2016) 194-203.
- [23] R. Lemlich, J. Arod, Adsorptive bubble separation techniques, Academic Press, (1972)
- [24] W. Walkowiak, Mechanism of selective ion flotation. 1. selective flotation of transition metal cations, Separation Science and Technology, 26 (1991) 559–568.
- [25] A.J.M. Valente, H.D. Burrows, S.M.A. Cruz, R.F.P. Pereira, A.C.F. Ribeiro, V.M.M. Lobo, Aggregation and micellization of sodium dodecyl sulfate in the presence of Ce(III) at different temperatures: A conductometric study, Journal of Colloid and Interface Science 323 (2008) 141-145.
- [26] R. Sadeghi, R. Golabiazar, Study of salt effects on the aggregation behavior of ionic liquid 1-dodecyl-3methylimidazolium bromide in aqueous solution, Journal of Molecular Liquids, 197 (2014) 176-183.
- [27] A.J.M. Valente, H.D. Burrows, R.F. Pereira, A.C.F. Ribeiro, J.L.G. Costa Pereira, V.M.M. Lobo, Effect of Europium(III) Chloride on the Aggregation Behavior of Sodium Dodecyl Sulfate, Langmuir, 22 (2006) 5625-5629.
- [28] R.F.P. Pereira, M.J. Tapia, A.J.M. Valente, H.D. Burrows, Effect of metal ion hydration on the interaction between sodium carboxylates and aluminum(III) or chromium(III) ions in aqueous solution, Langmuir, 28 (2011) 168-177.
- [29] A.C.S. Neves, A.J.M. Valente, H.D. Burrows, A.C.F. Ribeiro, V.M.M. Lobo, Effect of terbium(III) chloride on the micellization properties of sodium decyl- and dodecyl-sulfate solutions, Journal of Colloid and Interface Science, 306 (2007) 166-174.

- [5] K. Xu, T. Deng, J. Liu, W. Peng, Study on the recovery of gallium from phosphorus flue dust by leaching with spent sulfuric acid solution and precipitation, Hydrometallurgy, 86 (2007) 172-177.
- [6] Z. Fang, H.D. Gesser, Recovery of gallium from coal fly ash, Hydrometallurgy, 41 (1996) 187-200.
- [7] J.A. Sturgill, J.T. Swartzbaugh, P.M. Randall, Pollution prevention in the semiconductor industry through recovery and recycling of gallium and arsenic from GaAs polishing wastes, Clean Technologies and Environmental Policy, 2 (2000) 18-27.
- [8] H.S. Lee, C.W. Nam, A study on the extraction of gallium from gallium arsenide scrap, Hydrometallurgy, 49 (1998) 125-133
- [9] L. Stoica, M. Dinculescu, and C.G. Plapcianu, Mn(II) recovery from aqueous systems by flotation, Water Res, 32 (1998) 3021-3030.
- [10] L.K. Wang, Y.T. Hung, Adsorptive bubble separation and dispersed air flotation, In Advanced Physicochemical Treatment Processes, (2006) 81-122.
- [11] L.O. Filippov, III /Zeolites: ion exchangers, ion flotation, Laboratoire Environnement et Mine and ralurgie, (2000) 3179-3186.
- [12] R. B. Grieves, Foam separations: a review, The Chemical Engineering Journal, 9 (1975) 93-106.
- [13] R. Lemlich, Adsorptive bubble separation techniques, Elsevier, (1972). doi:10.1016/B978-0-12-443350-2.50005-8.
- [14] M. Reyes, M. Patiño, F. Tavera, F. Escudero, R. Rivera, I. Pérez, Kinetics and recovery of xanthate-copper compounds by ion flotation techniques, Journal of the Mexican Chemical Society, 1 (2009) 15–22
- [15] M. Reyes, F. Patiño, R. Escudero, M. Pérez, M.U. Flores, I.A. Reyes, kinetics and hydrodynamics of silver ion flotation, Journal of the Mexican Chemical Society, 56 (4) (2012) 408–416.
- [16] T. Kinoshita, Y. Ishigaki, N. Shibata, S. Akita, H. Kondou, S. Nii, Selective recovery of gold(III) via continuous counter-current foam separation from hydrochloric acid solution – Effects of foam and column sizes on separation performance, Separation and Purification Technology, 116 (2013) 335–341.
- [17] I.B. Scorzelli, A.L. Fragomeni, M.L. Torem, Removal of cadmium from a liquid effluent by ion flotation, Minerals Engineering, 12 (8) (1999) 905–917.
- [18] A.I. Zouboulis, K.A. Matis, Ion flotation in environmental technology, Chemosphere. 16 (1987) 623–631.

- [33] R.F.P. Pereira, A.J.M. Valente, M. Fernandes, H.D. Burrows, What drives the precipitation of long-chain calcium carboxylates (soaps) in aqueous solution?, Physical Chemistry Chemical Physics, 14 (2012) 7517– 7527.
- [34] C.M.R. Almeida, B.F.O. Nascimento, M. Pineiro, A.J.M. Valente, Thermodynamic study of the interaction between5,10,15,20-tetrakis-(N-methyl-4-pyridyl) porphyrin tetraiodine andsodium dodecyl sulfate, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 480 (2015) 279-286.
- [35] I.B. Scorzelli, A.L. Fragomeni, M.L. Torem, Removal of cadmium from a liquid effluent by ion flotation, Minerals Engineering, 12 (1999) 905–917.

- [30] R.F.P., Pereira, A.J.M. Valente, H.D. Burrows, Thermodynamic analysis of the interaction between trivalent metal ions and sodium dodecyl sulfate: An electrical conductance study, Journal of Molecular Liquids, 156 (2010) 109-114.
- [31] R.F.P. Pereira, A.J.M. Valente, H.D. Burrows, The interaction of long chain sodium carboxylates and sodium dodecylsulfate with lead(II) ions in aqueous solutions, Journal of Colloid and Interface Science, 414 (2014) 66-72.
- [32] R.F.P. Pereira, A.J.M. Valente, H.D. Burrows, M.L. Ramos, A.C.F. Ribeiro, V.M.M. Lobo, Flocculation and micellization of sodium dodecyl sulfate solutions in the presence of aluminium nitrate: effect of concentration and temperature, Acta Chimica Slovenica, 56 (1) (2009) 45-52.

برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده کنید:



Please cite this article using:

Z. Bahri, B. Rezai, E. Kowsari, Investigating mechanism of collector concentration on the selective separation of gallium from zinc using ion flotation, *Amirkabir J. Civil Eng.*, 50(6) (2019) 1145-1154. DOI: 10.22060/ceej.2018.11202.4987